

Bipolar transistor structure for use as a photodetector.

Patent Number: EP0339386, A3, B1
Publication date: 1989-11-02
Inventor(s): BOCK WOLFGANG
Applicant(s): SIEMENS AG (DE)
Requested Patent: JP2012975
Application Number: EP19890106622 19890413
Priority Number(s): DE19883814656 19880429
IPC Classification: H01L31/10
EC Classification: H01L29/08B, H01L31/11B, H01L29/732C
Equivalents:

Abstract

The bipolar transistor structure has a vertical emitter/base/collector sequence in which the emitter (13) is connected to a metallic emitter contact (19) via an emitter terminal region (18). The emitter terminal region (18) extends beyond the emitter (13) onto the surface of the substrate (10) containing the bipolar transistor structure. The emitter contact (19) only partially spans the emitter terminal region (18) so that the emitter (13) is not underneath the emitter contact (19) in the region of the vertical emitter/base/collector sequence. The emitter terminal region (18) is transparent to light in the region of the vertical emitter/base/collector sequence and is also covered only by layers (21) permeable to light in this region, so that a direct irradiation of light into the active transistor region is possible. In particular, bipolar transistor structures which have been produced in a self-aligned manner in a double polysilicon process are suitable for use as phototransistors for detecting optical data rates in the Gbit/s region directly inside high-density silicon bipolar circuits. ■

Data supplied from the esp@cenet database - I2

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 89106622.7

Int. Cl. 4: H01L 31/10

Anmeldetag: 13.04.89

Priorität: 29.04.88 DE 3814656

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.11.89 Patentblatt 89/44

Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL

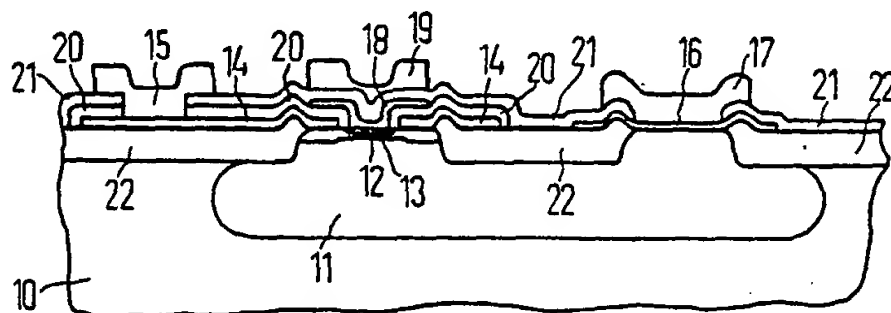
Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
 Wittelsbacherplatz 2
 D-8000 München 2(DE)

Erfinder: Bock, Wolfgang
 Hessesstrasse 42
 D-8000 München 40(DE)

Als Fotodetektor verwendbare Bipolartransistorstruktur.

Die Bipolartransistorstruktur weist eine vertikale Emitter-Basis-Kollektorfolge auf, in der der Emitter (13) über einen Emitteranschlußbereich (18) mit einem metallischen Emitterkontakt (19) verbunden ist. Der Emitteranschlußbereich (18) erstreckt sich über den Emitter (13) hinaus auf die Oberfläche des die Bipolartransistorstruktur enthaltenden Substrats (10). Der Emitterkontakt (19) überdeckt den Emitteranschlußbereich (18) nur teilweise, so daß der Emitter (13) im Bereich der vertikalen Emitter-Basis-Kollektorfolge nicht unterhalb des Emitterkontakts (19) liegt. Der Emitteranschlußbereich (18) ist im Bereich der vertikalen Emitter-Basis-Kollektorfolge lichtdurchlässig und in diesem Bereich auch nur von lichtdurchlässigen Schichten (21) bedeckt, so daß ein direktes Einstrahlen von Licht in den aktiven Transistorbereich möglich ist. Insbesondere Bipolartransistorstrukturen, die in einem Doppel-Polysilizium-Prozeß selbstjustiert gebildet sind, sind zur Verwendung als Fototransistoren zur Detektion von optischen Datenraten im Gbit/s-Bereich direkt innerhalb hochintegrierter Silizium-Bipolarschaltungen geeignet.

FIG 3



Xerox Copy Centre

EP 0 339 386 A2

Als Fotodetektor verwendbare Bipolartransistorstruktur

Die Erfindung betrifft eine Bipolartransistorstruktur in einem Siliziumsubstrat mit vertikaler Emitter-Basis-Kollektorfolge, mit einem Emitteranschlußbereich und einem metallischen Emitterkontakt.

Zur optischen Detektion in der Nachrichtentechnik werden Fotodetektoren und low-noise Verstärker verwendet. Im Interesse einer großen detektierbaren Datenrate werden Anordnungen mit hohen Schaltgeschwindigkeiten angestrebt.

Eine monolithische Integration von Fotodetektoren und Verstärkerstufen ist z.B. aus Wang H., Ankri D., "Monolithic integrated photoreceiver implemented with GaAs/GaAlAs heterojunction bipolar phototransistor and transistors", Electron. Lett., 1986, 22, Seiten 391-393, aus Bar-Chaim N., Harder Ch., Katz J., Margalit S., Yariv A., Ury I.: "Monolithic integration of a GaAlAs buried-heterostructure laser and a bipolar phototransistor", Appl. Phys. Lett., 1982, Band 40(7), Seiten 556-557 bekannt. Dabei werden aus $A_{III}B_V$ Materialien bestehende Fotodetektoren in integrierte Schaltungen eingebaut. Damit können empfindliche Fotodetektoren mit einem guten Frequenzverhalten hergestellt werden, eine hohe Integration wird jedoch nicht erreicht.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine lichtempfindliche Halbleiterstruktur anzugeben mit hohen Schaltgeschwindigkeiten, die zur Integration in hochintegrierte Schaltungen geeignet ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Bipolartransistorstruktur der eingangs genannten Art gelöst, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

- a) der Emitteranschlußbereich erstreckt sich über den Emitter hinaus auf die Substratoberfläche,
- b) der Metallmitterkontakt überdeckt den Emitteranschlußbereich nur teilweise, so daß der Emitter im Bereich der vertikalen Emitter-Basis-Kollektorfolge nicht unterhalb des Metallmitterkontaktes liegt,
- c) der Emitteranschlußbereich ist im Bereich der vertikalen Emitter-Basis-Kollektorfolge lichtdurchlässig und in diesem Bereich auch nur von schwachabsorbierenden Schichten bedeckt.

Da der aktive Transistorbereich, der durch die vertikale Emitter-Basis-Kollektorfolge gebildet wird, nur von lichtdurchlässigen Schichten bedeckt ist, ist es möglich, mit Licht direkt in die Bipolartransistorstruktur einzustrahlen. Das Licht erzeugt in der aus Basis und Kollektor gebildeten Diode (BC-Diode) Elektronen-Lochpaare, die einen Fotostrom verursachen. Die Bipolartransistorstruktur bildet einen Fotodetektor.

Es ist besonders vorteilhaft, Bipolartransistoren zu verwenden, die durch einen selbstjustierenden Doppelpolysilizium-Prozeß gebildet sind. Diese Bipolartransistoren weisen hohe Schaltgeschwindigkeiten auf (siehe z.B. Wieder A.W.: "Self-aligned bipolar technology-new chances for very high-speed digital integrated circuits", Siemens Forsch.-& Entwicklungsber., 1984, Band 13, Seiten 246-252). Damit ist in diesem Fall die detektierbare Datenrate gekoppelt mit der hohen Schaltgeschwindigkeit der Bipolartransistoren. Zur Herstellung der Bipolartransistorstruktur ist lediglich eine horizontale Deplazierung des Emitterkontaktes gegenüber der vertikalen Emitter-Basis-Kollektorfolge erforderlich. Die Bipolartransistorstruktur kann daher innerhalb von integrierten Schaltungen mit einem bekannten Bipolarprozeß (wie z.B. in Wieder A.W.: "Self-aligned bipolar technology-new chances for very highspeed digital integrated circuits", Siemens Forsch.-& Entwicklungsber., 1984, Band 13, auf den Seiten 246 - 252 beschrieben) hergestellt werden. Dadurch wird ein hohes Maß an Integration erzielt.

Die Bipolartransistorstruktur ist besonders geeignet zur Detektion von optischen Datenraten im Gbit/s-Bereich mit Wellenlängen kleiner:gleich 900 nm innerhalb von hochintegrierten Si-Bipolarschaltungen, da die Energie von Licht dieser Wellenlänge ausreicht, um in Silizium Elektron-Lochpaare zu erzeugen.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren 1 bis 4 und eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

FIG 1 zeigt in schematischer Darstellung den Versuchsaufbau zur Messung der Fotoempfindlichkeit der Bipolartransistorstruktur.

FIG 2 zeigt die Abhängigkeit des Fotostroms von der eingestrahnten Lichtleistung bei der Messung in einer Anordnung nach FIG 1.

FIG 3 zeigt einen Schnitt durch einen selbstjustierten Bipolartransistor gemäß der Erfindung.

FIG 4 zeigt eine Draufsicht auf den Bipolartransistor aus FIG 3.

FIG 1 zeigt das Ersatzschaltbild eines Versuchsaufbaus zum Nachweis der Fotoempfindlichkeit eines erfindungsgemäßen Bipolartransistor, der durch einen selbstjustierenden Doppelpolysiliziumprozeß gebildet wurde. Das Licht einer Laserdiode 1 wird mit Hilfe einer Linsenanordnung 2 auf die aus Basis und Kollektor der Bipolartransistorstruktur gebildete Basis-Kollektordiode 3 fokussiert. Die Laserdiode 1 emittiert Licht einer Wellenlänge $\lambda = 830$ nm.

Der verwendete Bipolartransistor weist folgende Daten auf: Selbstjustierter npn-Transistor, Emittterfläche $2 \times 8 \mu\text{m}^2$, Basisfläche $6 \times 12 \mu\text{m}^2$, Basisweite $0,2 \mu\text{m}$, Tiefe des vergrabenen Kollektors $1,6 \mu\text{m}$, Basiswiderstand 150Ω , Kollektorstromwiderstand 50Ω , Kapazität des Basiskollektorübergangs 50 fF .

Mit einem Strommeßgerät 4 (siehe FIG 1) wird der in der Basiskollektordiode 3 erzeugte Fotostrom nachgewiesen.

Die Abhängigkeit des nachgewiesenen Fotostroms I_{photo} von der eingestrahlten Lichtleistung P_{opt} ist in FIG 2 dargestellt. Es zeigt sich eine lineare Abhängigkeit des Photostromes I_{photo} von der Lichtleistung P_{opt} . Licht der Wellenlänge 830 nm dringt etwa $20 \mu\text{m}$ tief in Silizium ein. Verglichen mit der Tiefe des Kollektors von $1,6 \mu\text{m}$ bedeutet diese Reichweite, daß der Bipolartransistor für das Licht durchlässig ist.

In FIG 3 ist ein erfindungsgemäßer durch einen Doppelpolysiliziumprozeß hergestellter Bipolartransistor dargestellt. Ein Substrat 10 aus Silizium enthält Feldoxidbereiche 22, die zur Trennung der aktiven Bauelementbereiche innerhalb des Substrats 10 dienen. Im Substrat 10 ist ein n-dotierter Kollektor 11, eine p-dotierte Basis 12 und ein n-dotierter Emittter 13 vorgesehen. Der Kollektor 11, die Basis 12 und der Emittter 13 sind so angeordnet, daß ihre aktiven Bereiche eine vertikale Folge bilden. Die Basis 12 ist so gestaltet, daß ihr inaktiver Bereich den Emittter 13 ringförmig umschließt. Über einen Basisanschlußbereich 14, der aus p-dotiertem Polysilizium besteht, ist die Basis 12 mit einem Basiskontakt 15 verbunden. Der Basisanschlußbereich sowie 14 dessen Flanken außerhalb des Bereichs des Basiskontaktes 15 sind mit einer Isolationsschicht 20 bedeckt. Der Kollektor 11 ist über einen Kollektoranschlußbereich 16, der aus n-dotiertem Polysilizium besteht, mit einem Kollektorkontakt 17 verbunden. Der Emittter 13 ist über einen Emittteranschlußbereich 18 mit einem Emittterkontakt 19 verbunden. Die freiliegende Oberfläche des Bipolartransistors ist mit einer schützenden Oxidschicht 21 bedeckt. Der Emittteranschlußbereich 18 ist so ausgebildet, daß der Emittterkontakt 19 außerhalb des Bereichs des aktiven Transistors angebracht werden kann.

Die Lage des Basiskontakts 15, des Kollektorkontakts 17, des Emittterkontakts 19 und des aktiven Transistorbereichs 23 wird anhand von FIG 4, die eine Draufsicht des Bipolartransistors aus FIG 3 darstellt, näher erläutert. Der Basiskontakt 15 und der Kollektorkontakt 17 liegen auf einer Linie in der Oberfläche des Substrats 10, durch die der in FIG 3 dargestellte Schnitt III-III durch den Bipolartransistor gelegt ist. Zwischen dem Basiskontakt 15 und dem Kollektorkontakt 17 liegt ein aktiver Transistorbereich 23, der durch die vertikale Folge von Kol-

lektor 11, Basis 12 und Emittter 13 definiert wird. Er liegt auf derselben Linie wie der Basiskontakt 15 und der Kollektorkontakt 17. Seitlich versetzt zur Lage des Basiskontakts 15, des Kollektorkontakts 17 und des aktiven Transistorbereichs 23 ist der Emittterkontakt 19 angeordnet. Dadurch wird sichergestellt, daß mit Licht direkt in den aktiven Transistorbereich 23 eingestrahlt werden kann. Dank der geringen Absorption von Licht einer Wellenlänge kleiner oder gleich 900 nm (Reichweite für $\lambda = 830 \text{ nm}$ ca. $20 \mu\text{m}$) kann der Emittteranschlußbereich 18 (s. FIG 3) seine übliche Dicke haben.

Der beschriebene lichtempfindliche Bipolartransistor hat den Vorteil, daß er im bekannten Bipolarprozeß (siehe z.B. Wieder A.W.: Self-aligned bipolar technology-new chances for very high-speed digital integrated circuits, Siemens Forsch.-& Entwicklungsber., 1984, Band. 13, Seite 246-252) hergestellt werden kann, wobei kein zusätzlicher Prozeßschritt benötigt wird. Lediglich das Kontaktloch für den Emittterkontakt 19 muß an anderer Stelle angebracht werden. Die Eigenschaften des Bipolartransistors erlauben eine Detektion einer optischen Datenrate von bis zu $2,5 \text{ Gbit/s}$.

Ansprüche

1. Bipolartransistorstruktur in einem Siliziumsubstrat mit vertikaler Emittter-Basis-Kollektorfolge, mit einem Emittteranschlußbereich und einem metallischen Emittterkontakt **gekennzeichnet** durch folgende Merkmale:

a) der Emittteranschlußbereich (18) erstreckt sich über den Emittter (13) hinaus auf die Oberfläche des Substrats (10),

b) der Emittterkontakt (19) überdeckt den Emittteranschlußbereich (18) nur teilweise, so daß der Emittter (13) im Bereich der vertikalen Emittter-Basis-Kollektorfolge nicht unterhalb des Emittterkontakts (19) liegt,

c) der Emittteranschlußbereich (18) ist im Bereich der vertikalen Emittter-Basis-Kollektorfolge lichtdurchlässig und in diesem Bereich auch nur von schwach absorbierenden Schichten bedeckt.

2. Bipolartransistorstruktur nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Emittteranschlußbereich (18) durch einen Doppelpolysiliziumprozeß selbstjustiert gebildet ist.

3. Bipolartransistorstruktur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Basis (12) p-dotiert ist, Emittter (13) und Kollektor (11) n-dotiert sind.

4. Verwendung einer Bipolartransistorstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Detektion von optischen Datenraten im Gbit/s -Bereich mit

Wellenlängen kleiner/gleich 900 nm innerhalb
hochintegrierter Siliziumbipolarschaltungen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG 1

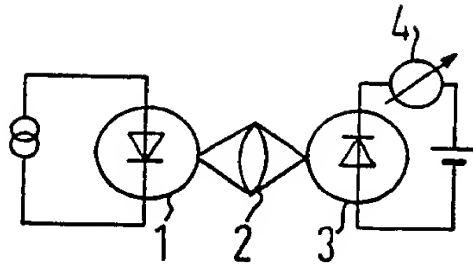


FIG 2

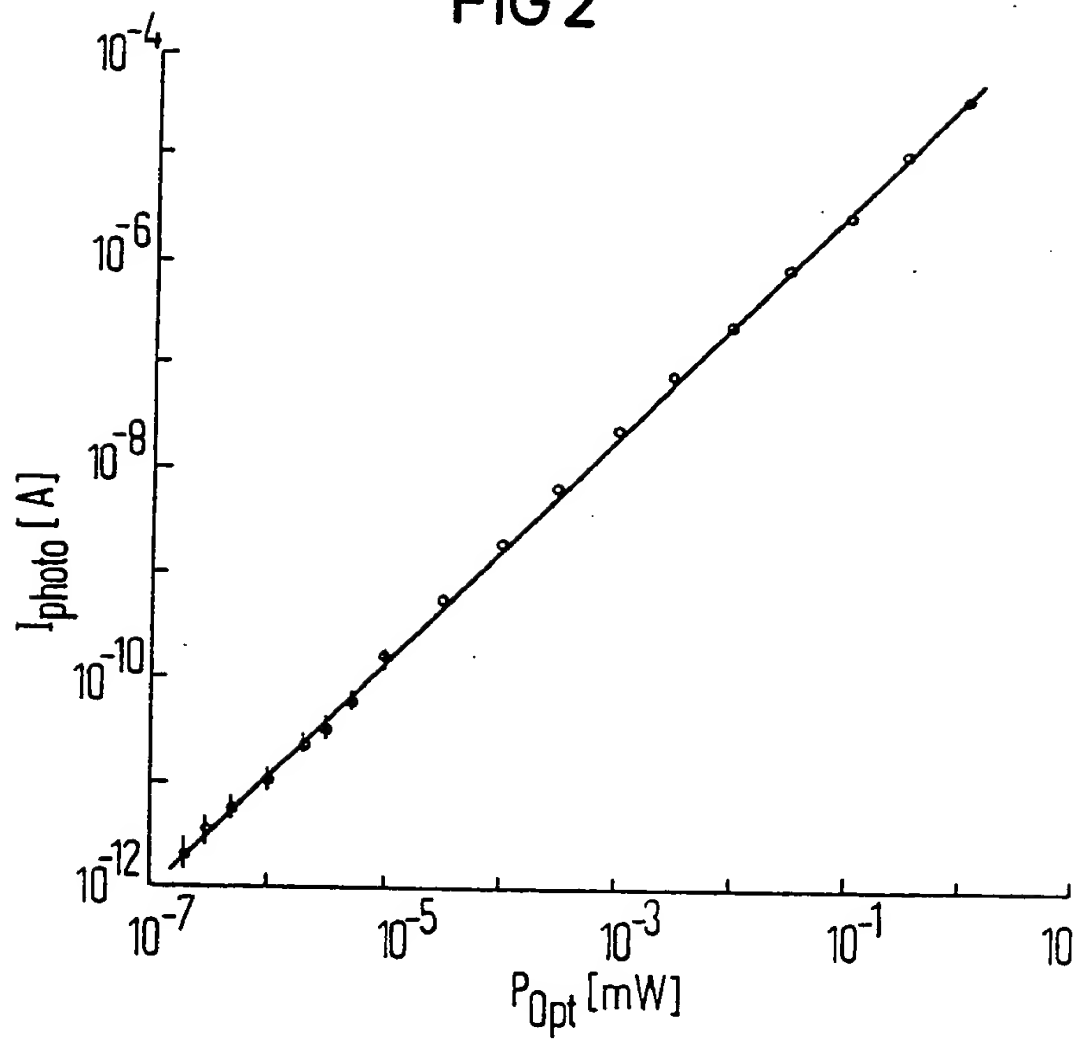


FIG 3

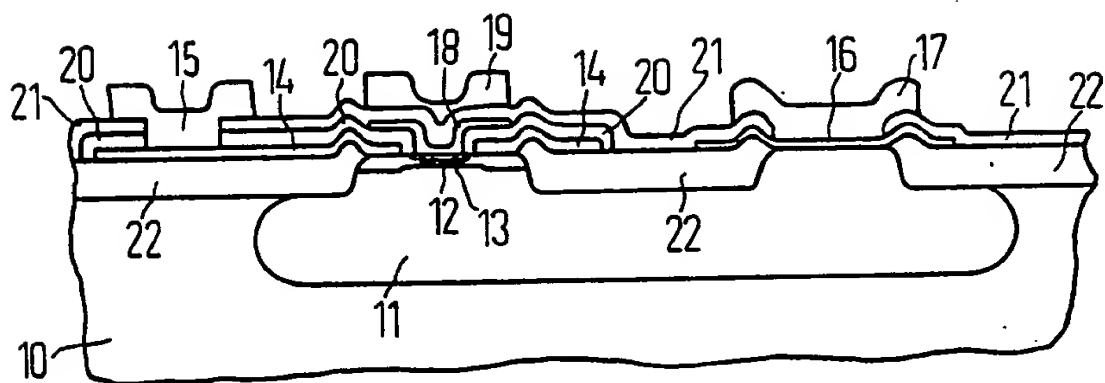
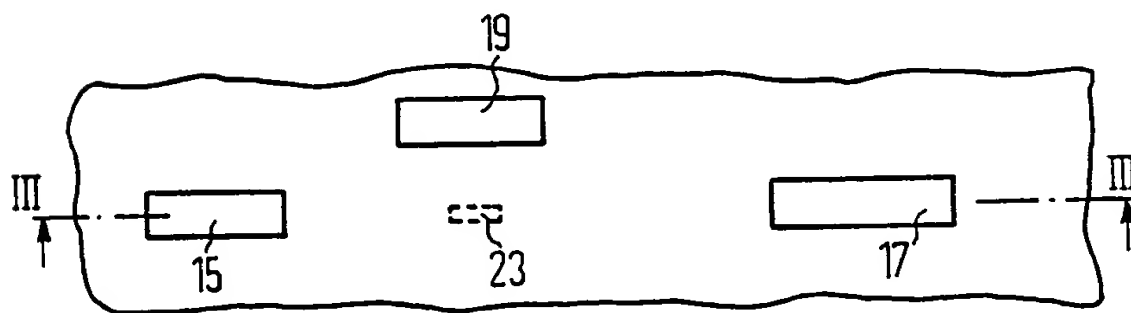


FIG 4





Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 339 386
A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **89106622.7**

(51) Int. Cl.⁵: **H01L 31/10**

(22) Anmeldetag: **13.04.89**

(30) Priorität: **29.04.88 DE 3814656**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.11.89 Patentblatt 89/44

(64) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL

(68) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **19.09.90 Patentblatt 90/38**

(71) Anmelder: **Siemens Aktiengesellschaft**
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

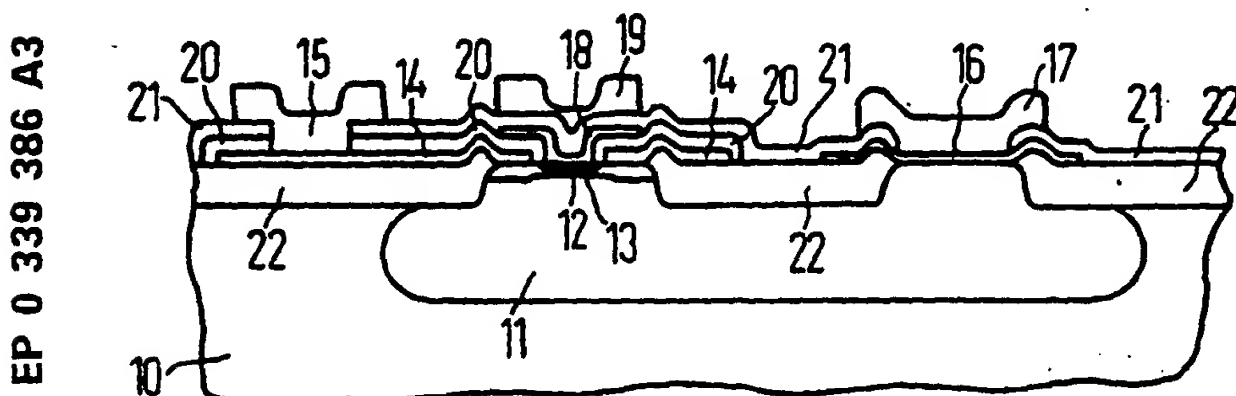
(72) Erfinder: **Bock, Wolfgang**
Hessstrasse 42
D-8000 München 40(DE)

(54) Als Fotodetektor verwendbare Bipolartransistorstruktur.

(57) Die Bipolartransistorstruktur weist eine vertikale Emitter-Basis-Kollektorfolge auf, in der der Emitter (13) über einen Emitteranschlußbereich (18) mit einem metallischen Emitterkontakt (19) verbunden ist. Der Emitteranschlußbereich (18) erstreckt sich über den Emitter (13) hinaus auf die Oberfläche des die Bipolartransistorstruktur enthaltenden Substrats (10). Der Emitterkontakt (19) überdeckt den Emitteranschlußbereich (18) nur teilweise, so daß der Emitter (13) im Bereich der vertikalen Emitter-Basis-Kollektorfolge nicht unterhalb des Emitterkontakts (19)

liegt. Der Emitteranschlußbereich (18) ist im Bereich der vertikalen Emitter-Basis-Kollektorfolge lichtdurchlässig und in diesem Bereich auch nur von lichtdurchlässigen Schichten (21) bedeckt, so daß ein direktes Einstrahlen von Licht in den aktiven Transistorbereich möglich ist. Insbesondere Bipolartransistorstrukturen, die in einem Doppel-Polysilizium-Prozeß selbstjustiert gebildet sind, sind zur Verwendung als Fototransistoren zur Detektion von optischen Datenraten im Gbit/s-Bereich direkt innerhalb hochintegrierter Silizium-Bipolarschaltungen geeignet.

FIG 3



EP 0 339 386 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 10 6622

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
D,A	SIEMENS-FORSCH.- U. ENTWICKL.-BER., Band 13, Nr. 5, Mai 1984, Seiten 246-252, Springer-Verlag; A.W. WIEDER: "Self-aligned bipolar technology - new chances for very-high-speed digital integrated circuits" * Figur 5 *	1-3	H 01 L 31/10
A	DE-A-3 001 899 (LICENTIA PATENT-VERWALTUNG) * Figuren *	1,4	
P,X	ELECTRONICS LETTERS, Band 24, Nr. 13, 23. Juni 1988, Seiten 808-810, Stevenage, Herts, GB; W. BOCK et al.: "Optical detection up to 2.5 Gbit/s with a standard high-speed self-aligned silicon bipolar transistor" * Das ganze Dokument *	1-4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			H 01 L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 28-06-1990	Prüfer GORI P.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	